

В магнетиках с одноосной магн. анизотропией Б. с. является 180-градусной и поворот в ней вектора  $\mathbf{M}$  описывается ф-цией

$$\sin \theta(x) = \pm [\operatorname{ch}(x/\sqrt{A/K})]^{-1},$$

где  $\theta$  — угол между  $\mathbf{M}$  и осью лёгкого намагничивания,  $x$  — расстояние вдоль нормали к Б. с.,  $A$  — параметр обменного взаимодействия,  $K$  — константа анизотропии. Два знака ( $\pm$ ) в ф-це соответствуют двум типам Б. с. (Б. с. с противоположной полярностью), отличающимся направлением поворота  $\mathbf{M}$  по часовой стрелке и против неё (право- и левовращающие относительные нормали к Б. с.).

Расстояние вдоль нормали к Б. с., на к-ром осуществляется поворот вектора  $\mathbf{M}$ , наз. толщиной Б. с. Толщину 180-градусной стенки принимают равной  $\delta_B = \pi(A/K)^{1/2}$ . Плотность энергии Б. с.  $\sigma \approx 4(A \cdot K)^{1/2}$ . Для Со  $A = 2.1 \cdot 10^{-11}$  Дж/м,  $K = 9 \cdot 10^5$  Дж/м<sup>3</sup>,  $\delta_B = 150$  Å и  $\sigma = 4 \cdot 10^{-3}$  Дж/м<sup>2</sup>.

В магнитомногосном кристалле на микроструктуру Б. с. может влиять магнитоупругое взаимодействие, а в тонких пленках — диполь-дипольное взаимодействие.

В тонких пленках магнитных микроструктур Б. с. более сложная, в частности распределение  $\mathbf{M}$  может быть асимметричным относительно плоскости, нормальной к поверхности пленки. Возможна такжестыковка двух Б. с. с разной полярностью, что ведёт к образованию т. н. стенки с переменной полярностью. Переходный слой, образующийся в областистыковки, наз. блоховской линией (см. Блоха линия).

Б. с. обладают инерционными свойствами, им приписываются эффективную массу.

Лит.: Вонсовский С. В., Магнетизм, М., 1971; Современная кристаллография, т. 4, М., 1981, с. 250.

Б. Н. Филиппов.

**БЛОХА ТЕОРЕМА** — фундаментальная теорема квантовой теории твёрдого тела, устанавливающая вид волновой ф-ции электрона, находящегося в поле с периодич. потенциалом  $U$ , в частности в кристаллич. решётке. Сформулирована Ф. Блохом (F. Bloch) в 1929. Б. т. утверждает, что если потенциал  $U(\mathbf{r})$  ( $\mathbf{r}$  — пространственная координата) — ф-ция с периодом  $\mathbf{a}$  кристаллич. решётки:  $U(\mathbf{r} + \mathbf{a}) = U(\mathbf{r})$ , где  $\mathbf{a} = n_1 \mathbf{a}_1 + n_2 \mathbf{a}_2 + n_3 \mathbf{a}_3$ ;  $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3$  — основные (базисные) векторы решётки;  $n_1, n_2, n_3$  — целые числа ( $> 0$ ), то решения  $\psi(\mathbf{r})$  одноэлектронного Шредингера уравнения (адиабатическое приближение)

$$\hat{H}\psi(\mathbf{r}) = \left[ -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + U(\mathbf{r}) \right] \psi(\mathbf{r}) = \mathcal{E}\psi(\mathbf{r}) \quad (1)$$

( $\mathcal{E}$  — энергия частицы) имеют вид:

$$\psi_{\mathbf{k}}(\mathbf{r}) = e^{i\mathbf{k}\mathbf{r}} u_{\mathbf{k}}(\mathbf{r}). \quad (2)$$

Здесь  $\mathbf{k}$  — волновой вектор, характеризующий состояние электрона,  $u_{\mathbf{k}}$  — периодич. ф-ция с периодом решётки,  $m$  — масса электрона. Б. т. является следствием трансляционной инвариантности кристаллич. решётки. Если  $\psi(\mathbf{r})$  — решение ур-ния (1), соответствующее стационарному состоянию электрона с энергией  $\mathcal{E}$ , то  $\psi(\mathbf{r} + \mathbf{a})$  также является его решением, причём  $\psi(\mathbf{r} + \mathbf{a}) = C_a \psi(\mathbf{r})$ , где  $C_a = \pm 1$ .

Если стационарному состоянию с энергией  $\mathcal{E}$  соответствует неск. разл. волновых ф-ций  $\psi(\mathbf{r})$  (т. е. состояния с энергией  $\mathcal{E}$  — вырожденное), то волновая ф-ция  $\psi(\mathbf{r} + \mathbf{a})$  является линейной комбинацией всех собств. ф-ций  $\psi(\mathbf{r})$ , отвечающих вырожденному уровню  $\mathcal{E}$ . В этом случае  $C_a = e^{i\mathbf{k}\mathbf{a}}$ , причём волновой вектор  $\mathbf{k}$  определён с точностью до вектора обратной решётки  $\mathbf{g}$ . Т. о., в случае вырождения имеем:

$$\psi(\mathbf{r} + \mathbf{a}) = e^{i\mathbf{k}\mathbf{a}} \psi(\mathbf{r}). \quad (3)$$

Ф-ции, удовлетворяющие условию (3) (условию Блоха), называются блоховскими ф-циями.

Подставляя (2) в ур-ние Шредингера (1), получим ур-ние для  $u_{\mathbf{k}}(\mathbf{r})$ :

$$\left[ -\frac{\hbar^2}{2m} (\nabla + \mathbf{k})^2 + U(\mathbf{r}) \right] u_{\mathbf{k}}(\mathbf{r}) = \mathcal{E}_{\mathbf{k}} u_{\mathbf{k}}(\mathbf{r}), \quad (4)$$

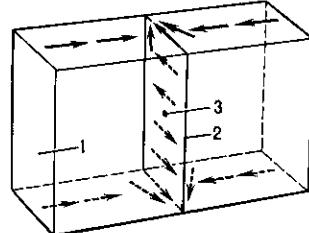
к-рое имеет бесконечный ряд решений  $u_{sk}(\mathbf{r})$ . Индекс  $s$  нумерует решения при заданном  $k$ . Волновым ф-циям (2) при заданном  $k$ , т. о., соответствуют дискретные значения энергии:  $\mathcal{E} = \mathcal{E}_s(k)$ ,  $s = 1, 2, \dots$  Индекс  $s$  — номер энергетич. зоны; зависимость  $\mathcal{E}_s$  от  $k$  при фиксированном  $s$  называется дисперсией законом частицы в  $s$ -й зоне (см. Зонная теория, Блоховские электроны).

Лит.: Заимова Д. Ж., Принципы теории твёрдого тела, пер. с англ., М., 1971; Принципы теории твёрдого тела, пер. с англ., М., 1974; Статистическая физика, ч. 2, М., 1978.

В. М. Винокур.

**БЛОХА ТОЧКА** (блоховская точка) — сингулярная точка на блоховской линии (см. Блоха линия), отделяющая два участка этой линии с противоположными направлениями разворота вектора намагниченности  $\mathbf{M}$  на них (рис.).

На сфере бесконечно малого радиуса с центром в Б. т. можно найти все возможные направления  $\mathbf{M}$ . Это означает, что в самой Б. т. вектор  $\mathbf{M}$  резко изменяется, так



Схематическое изображение блоховской точки (3) на блоховской стенке, содержащей вертикальную блоховскую линию (2). Стрелками изображено распределение  $\mathbf{M}$  в срединной плоскости вертикальной блоховской стенки (1) вблизи блоховской точки.

что градиент ф-ции  $M(r)$  ( $r$  — радиус-вектор точки об разца) в Б. т., а следовательно, и плотность обменной энергии (её неоднородная часть) в этой точке стремятся к бесконечности (в континуальном приближении). Однако полная обменная энергия сферы малого радиуса с центром в Б. т. конечна, так что энергия Б. т.  $E_{B.t.}$  (разность энергий блоховской линии при наличии и отсутствии Б. т.) оказывается конечной:

$$E_{B.t.} = 2\pi A^{3/2} K^{-1/2} \left( \ln \frac{K}{2\pi M_s^2} + 1,90 \right),$$

где  $A$  — параметр обменного взаимодействия,  $K$  — константа магнитной анизотропии,  $M_s$  — намагниченность насыщения.

Б. т. играет важную роль в теории доменных стенок.

Лит.: Малоземов А., Слонузский Д. Ж., Доменные стеки в материалах с цилиндрическими магнитными доменами, пер. с англ., М., 1982.

Б. Н. Филиппов.

**БЛОХА УРАВНЕНИЕ** — ур-ние квантовой статистики для ненормируемого статистического оператора квантового канонического распределения Гиббса:  $\rho = \exp(-\beta H)$ ,  $\beta = 1/kT$ ,  $T$  — темп-ра. Установлено Ф. Блохом (F. Bloch) в 1932. Б. у. имеет вид:  $d\rho/d\beta = -H\rho$  с нач. условием  $\rho|_{\beta=0}=1$ . Б. у. аналогично ур-нию Шредингера для мнимого времени и формально переходит в него при замене  $\beta$  на  $i\tau/\hbar$ , где  $\tau$  — время. Эта формальная аналогия позволяет использовать методы квантовой механики в квантовой статистике.

Д. Н. Зубарев.

**БЛОХА ФУНКЦИИ** — см. в ст. Блоха теорема, Блоховские электроны.

**БЛОХА—ГРЮНАЙЗЕНА ФОРМУЛА** — описывает температурную зависимость той части уд. электросопротивления  $\rho$  металлов, к-рая обусловлена рассеянием электронов на тепловых колебаниях кристаллич. решётки (фононах):

$$\frac{1}{\tau} = \frac{9\pi^2}{\hbar k} \cdot \frac{c^2}{\theta_D} \cdot \frac{m^*}{M} \cdot \frac{1}{(ak_F)^3} \cdot \left( \frac{T}{\theta_D} \right)^5 F_5 \left( \frac{T}{\theta_D} \right);$$

$$F_5(x) = \int_0^x \frac{z^6 dz}{(e^z - 1)(1 - e^{-z})}.$$